文章编号: 0253-2239(2010)01-0137-05

高重复频率窄脉宽 LGS 电光调 Q Nd:YVO4激光器

唐 昊^{1,2} 朱小磊^{1,2} 孟俊清^{1,2} 臧华国^{1,2}

(1中国科学院上海光学精密机械研究所,上海 201800;2上海市全固态激光器与应用技术重点实验室,上海 201800)

摘要 报道了一种激光二极管(LD)端面连续抽运的高重复率电光调 Q Nd:YVO4激光器。采用新型电光晶体 La₃Ga₅SiO₁₄(LGS)作为调 Q 元件,并设计高效稳定谐振腔,实现了最高 30 kHz 的高重复率电光调 Q 运转。使用 透射率为 50%的输出镜,在 5 kHz 重复率运转时,获得了单脉冲能量 0.4 mJ,脉宽 6.3 ns 的脉冲序列输出;当重复 率达 30 kHz 时,得到的单脉冲能量为 0.2 mJ,脉宽 9.1 ns,最大平均功率 6.2 W,斜率效率为 32.7%,调 Q 动静比 达 83%,光束传输因子 M² < 2。实验结果表明,该激光器输出功率并没有出现饱和现象,具有进一步提升的空间。 关键词 激光器;LGS 晶体;高重复率;电光调 Q

中图分类号 TN248.1 文献标识码 A doi: 10.3788/AOS20103001.0137

High Repetition Rate Short Pulse Width LGS Electro-Optic Q-Switched Nd:YVO₄ Laser

Tang Hao^{1,2} Zhu Xiaolei^{1,2} Meng Junqing^{1,2} Zang Huaguo^{1,2}

(¹ Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800, China ² Shanghai Key Laboratory of All Solid-State Laser and Applied Techniques, Shanghai 201800, China

Abstract An electro-optic (EO) *Q*-switched Nd: YVO₄ laser with high repetition rate of 30 kHz, end-pumped by a continuous-wave (CW) laser diode (LD) is reported. Using $La_3 Ga_5 SiO_{14}$ (LGS) single crystal as an EO *Q*-switch and designing an efficient and stable resonator, the repetition rate of EO *Q*-switched operation can be changed from 1 Hz to 30 kHz. Using an output coupler with transmittance of 50%, an output pulse train with pulse energy of 0.4 mJ and pulse width of 6.3 ns is obtained at the repetition rate of 5 kHz. An average output power of 6.2 W with the pulse width of 9.1 ns is obtained when the repetition rate reaches 30 kHz, the slope efficiency and dynamic to static ratio are 32.7% and 83%, respectively. The beam transfer factor M^2 is measured to be less than 2. Experimental results show that the output level has great potential for further development.

Key words lasers; LGS crystal; high repetition rate; electro-optic Q-switched

1 引 言

激光二极管(LD)抽运的固体激光器(DPSSL) 以其转换效率高、光束质量好、结构紧凑、使用和维 护方便等优点得到了人们的广泛关注。尤其是高重 复率窄脉宽固体激光器,在激光雷达、空间通信、激 光测距以及激光精细加工等领域^[1~4]都有着十分重 要的应用。目前,高重复率固体激光器大都采用被 动Q开关或声光Q开关作为调Q元件^[5,6]。但这两 种 Q 开关都有各自的不足:被动 Q 开关的工作稳定 性差,且单脉冲能量较低;声光 Q 开关的开关速度 慢,所得的脉冲脉宽一般在 10~100 ns 量级。而电 光 Q 开关可以弥补上述不足,容易获得 10 ns 以下 的稳定脉冲输出,但由于受到驱动源和调 Q 晶体本 身性能、制备方面的限制,目前报道的工作频率可在 10 kHz 以上的高重复率电光调 Q 激光器还较少,应 用也不是很普遍。在高重复率电光 Q 开关的研制

作者简介: 唐 吴(1984—), 男, 硕士研究生, 主要从事全固态激光器高复率电光调 Q 技术方面的研究。

E-mail: tanghao_1984@163.com

导师简介:朱小磊(1966—),男,研究员,博士生导师,主要从事固体激光技术和激光应用系统等方面的研究。

E-mail: xlzhu@mail. siom. ac. cn

收稿日期: 2009-02-17; 收到修改稿日期: 2009-03-30

方面,较成熟的产品是英国 LEYSOP 公司生产的可 以在 200 kHz 重复频率工作的 RbTiOPO₄(RTP)电 光Q开关,但未见有使用该Q开关进行激光器系统 研究的报道。而在高重复率电光调 Q 激光器的实 验研究方面,2003年德国夫琅禾费激光技术所的杜 可明等^[7]用 β-BaB₂O₄ (BBO) 晶体进行电光调 Q 得 到了重复频率 50 kHz,脉宽 9.5 ns 的激光输出。 2005年美国波士顿应用技术公司 Y. K. Zou 等^[8] 利用 Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O₃-PbTiO₃(PMN-ZT)光学陶 瓷进行了电光调Q的实验研究,调Q重复频率可高 达 200 kHz,脉宽 13 ns,但未给出脉冲能量和输出 功率方面的信息。2008年山东大学赵佳等[9]利用 RTP 晶体获得了重复频率 40 kHz,脉宽 15.5 ns 的 电光调Q脉冲,但其光-光效率不到10%。近年来, 利用新型电光晶体 La₃Ga₅SiO₁₄(LGS)进行的电光 调Q实验研究取得了重大进展^[10~13],LGS 晶体不 但抗损伤阈值高、透光范围大、物理化学性能稳定, 而且插入损耗和压电效应小,特别适合于高重复率 运转。2006年中国科学院上海光学精密机械研究 所王春雨等[14]利用 LGS 晶体作为电光 Q 开关,获 得了最高重复频率 10 kHz 的 1064 nm 激光输出, 并指出其巨大的应用潜力。因此,利用 LGS 晶体作 为电光调 Q 元件,同时为了压缩脉宽和系统小型 化,在优化设计的超短谐振腔中,利用半导体制冷片 (TEC)对激光晶体进行传导冷却,获得了最高重复 频率 30 kHz、脉宽小于 10 ns 的 1064 nm 激光输 出,取得了较好的实验结果。小型化及传导冷却技 术的引入,为该激光器在空间的应用奠定了基础。

2 实验装置及原理分析

报

实验采用端面抽运方式,抽运源为带尾纤连续 输出的 808 nm LD,其数值孔径 NA 为 0.22,纤芯 直径为 400 μ m,在实验条件下,最大输出功率为 24 W。LD发出的抽运光经过放大率 1:1的光学耦 合系统后聚焦进激光晶体,实测焦点处光斑半径约 为 250 μ m。激光晶体使用适合高重复率运转的 Nd:YVO^[15]。谐振腔设计过程中,使用 LasCAD 软 件模拟加入激光晶体后的激光谐振腔,分析引入晶 体热效应后谐振腔的稳定性,最后得到一稳定的超 短激光谐振腔,图 1、图 2 分别为抽运功率为 25 W 时模拟谐振腔 TEM₀₀模模式图和不同抽运功率下 腔稳定性的变化情况。图 2 中,G₁•G₂ 为引入激光 晶体热效应后即将激光晶体视为可变焦距的热透镜 后的腔稳定性参数,其值由 LasCAD 软件计算得 出,此时谐振腔的稳定性条件为 0 < G₁•G₂ < 1。



图 1 谐振腔的 TEM₀₀模模式图 Fig. 1 TEM₀₀ mode of cavity



图 2 腔稳定性随抽运功率的变化关系 Fig. 2 Relation between the cavity stability and pump power

图 1 中,标号为 0 和 3 的界面分别表示后腔镜 和输出镜,而界面 1 和界面 2 之间的部分为激光晶 体。从图 1 中可以看到,谐振腔中 TEM₀₀模最大腰 斑半径为 259.1 µm,而激光晶体处的腰斑半径约为 256 µm,与抽运光焦点处的光斑半径接近,这种抽 运方式既能充分利用激光晶体处的 TEM₀₀模模体 积又能防止多模振荡,同时从图 2 可知,在抽运功率 范围内谐振腔皆具有较好的稳定性。另外,使用的 Nd:YVO4晶体掺杂浓度原子分数为 0.3%,较低的 掺杂浓度可以大大降低高重复率运转时激光晶体的 热效应,因此通过该谐振腔可获得较高的抽运效率 和较好的光束质量。图3为不同掺杂浓度时激光晶体内部温度分布的比较,其中部分仿真参数设置为: 抽运光选为旋转对称,焦斑大小设为250 μm;抽运 功率设为 25 W;边界冷却条件设为传导冷却,表面 温度设为 300 K;不同掺杂浓度下的吸收系数依据 吸收系数与掺杂浓度成正比的关系设置。



图 3 不同掺杂浓度下晶体的温度分布

Fig. 3 Temperature distribution of the laser crystal at different doping concentrations

掺杂浓度原子分数为 0.3%的晶体内部的温度 梯度,如图 3(a)所示,明显低于掺杂浓度原子分数 为 1%的晶体,如图 3(b)所示,且晶体热效应相应较 小。根据模拟的谐振腔,再插入调 Q 元件得到整个 实验装置如图 4 所示。



图 4 高重复率电光调 Q Nd:YVO4激光器装置图 Fig. 4 Schematic diagram of high repetition rate electro-optic Q-switched Nd:YVO4 laser

平-四谐振腔腔长为 105 mm,从左至右依次放 置后腔镜 M_1 、Nd:YVO4晶体、偏振片、四分之一波 片、LGS 晶体和耦合输出镜 M_2 。 M_1 四面的曲率半 径 R 为 250 mm,镀有 808 nm 增透膜和 1064 nm 全 反膜,耦合输出镜 M_2 为镀有 1064 nm 一定透射率 膜的平面镜。Nd:YVO4晶体为 a 轴切割,尺寸为 4 mm×4 mm×7 mm。4 mm×4 mm 的两个面作 为通光面,镀有 808 nm 和 1064 nm 增透膜,为了使 结构更加紧凑,将 Nd:YVO4晶体的非通光面安装 在 TEC 制冷的铜制热沉中,完全舍弃水循环冷却系 统,便于应用。电光调 Q 晶体 LGS 由山东大学提 供,尺寸为 4 mm×4 mm×40 mm,晶体采用 z 向通 光,x 方向加电压,如图 4 所示,LGS 晶体 10:1的纵 横比值,大大降低了调 Q 所需的电压值, $V_{\lambda/4}$ 理论 值仅为 1760 V,更有利于高重复频率驱动。

实验采用脉冲加压式电光调Q方式,偏振片、四分之一波片和LGS晶体共同构成Q开关。LGS晶体上

未加电压时,Q开关处于关闭状态;在LGS 晶体上加四分之一波电压后,腔内光束往返一次后偏振方向转过90°,Q开关打开,释放出巨脉冲,此种调Q方式的消光比较高,接近100:1^[12]。高频高压驱动源是实现高重复率电光调Q的关键部件,利用特殊的高频开关组件,自行研制驱动和控制电路,制成了高重复率电光调Q驱动源,输出重复频率在0~30 kHz 范围内连续可调,高压输出最高可达4 kV。

3 实验结果

首先考察低重复率运转时激光器的输出特性, 在重复频率为5 kHz的条件下,当使用透射率 T= 50%的耦合输出镜时,实验获得最佳耦合输出,最大 单脉冲能量为 0.4 mJ,相应脉宽为 6.3 ns,脉冲波 形如图 5 所示。



图 5 5 kHz 时的调 Q 脉冲波形

Fig. 5 Q-switched pulse profile at 5 kHz

随后,使用透射率 T=50%的耦合输出镜,改变 电光 Q 开关重复频率,考察输出功率随重复频率的 变化情况。在 5~30 kHz 频率范围内,均获得了稳 定的调 Q 输出,实验测得的激光器输出功率变化结 果如图 6 所示。





由图 6 结果可以看出,当谐振腔内插入偏振片、 LGS 晶体和四分之一波片等调 Q 开关组件后,由于 存在一定的插入损耗,使得静态连续波输出的斜率 效率从 38.18%降低为 34.78%,但插入损耗的影响 并不严重。而 Q 脉冲输出功率曲线则表明,调 Q 输 出功率随着重复频率的增加而增加,并没有出现饱 和迹象。受高压驱动源功率所限,未能进行高于 30 kHz重复频率的实验。在重复频率为 30 kHz,抽 运功率为 24 W 时,获得最大平均功率输出 6.2 W, 按激光晶体实际吸收 22 W 抽运光功率计算,最大 光-光转换效率约为 28%,斜率效率为 32.7%,调 Q 动静比约为 83%,相应单脉冲能量和脉宽随抽运功 率的变化关系如图 7 所示。

分析图 7 的实验结果可以发现,在 30 kHz 重复 频率条件下,激光单脉冲能量随着抽运功率的增加 而增加,而脉宽随着抽运功率的增加而减小,当抽运 功率为 24 W时,获得最大单脉冲能量 0.2 mJ,最窄 脉宽 9.1 ns,相应峰值功率高达 22 kW。实验中用 示波器监测 30 kHz 重复频率下的调Q脉冲序列,





图 7 30 kHz 时单脉冲能量和脉宽随抽运功率的 变化曲线





图 8 30 kHz 时的调 Q 输出脉冲序列 Fig. 8 Q-switched pulse series at 30 kHz

用 Spiricon 公司生产的 M²-200 型光束传输分析 仪测量了重复频率为 30 kHz 时调 Q输出光的光束质 量,图 9(a)为抽运功率 10 W,输出功率约 2 W 时的测 量结果,此时, $M_x^2 = 1.50$, $M_y^2 = 1.39$,图 9(b)为激 光能量远场空间分布。在抽运功率范围内, M² 因子 皆小于 2,说明获得了高光束质量的窄脉冲激光。





4 结 论

利用新型电光晶体 LGS 作为调 Q 元件,通过 优化设计高效稳定谐振腔,实现了激光器高重复率 电光调 Q 运转,获得了最高重复频率 30 kHz 的窄 脉宽激光输出,最大平均功率达 6.2 W,斜率效率为 32.7%,且光束质量良好,在抽运功率范围内,光束 传输因子 M²<2。实验结果表明,激光功率输出水 平还有很大的提升空间,通过改进调 Q 驱动源就可 以获得平均功率更大、重复频率更高的激光输出。

参考文献

- 1 Zhou Tianhua, He ning. The laser remote sensing of underwater acoustic signal[C]. ISAPE '06.7th International Symposium on, 2006, 7: 1~4
- 2 Liu Liren. Laser communications in space [optical link and terminal technology[J]. Chinese J. Lasers, 2007, 34(1): 3~19 刘立人. 卫星激光通信 [链路和终端技术[J]. 中国激光, 2007, 34(1): 3~19
- Pan Qiujuan, Fang Qinghai, Yang Yan. Key technique and its progress in satellite laser ranging at high repetition rate[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2007, 44(7): 33~39
 潘秋娟,房庆海,杨 艳.高重复率卫星激光测距的关键技术及其

価权娟,厉仄两,彻 祀.同星发华卫生做几侧距的天健12个及其 进展[J]. 激光与光电子学进展,2007,44(7):33~39

- 4 H. Y. Zheng, H. Huang. Ultrasonic vibration-assisted femtosecond laser machining of microholes [J]. J. Micromech. Microeng, 2007, 17(8): 58~61
- 5 John J. Zayhowski, Alexander (Sandy) L. Wilson. Pumpinduced bleaching of the saturable absorber in short-pulse Nd: YAG/Cr⁴⁺: YAG passively *Q*-switched microchip lasers [J]. *IEEE J. Quant. Electron.*, 2003, **39**(12): 1588~1593
- 6 Yao Baoquan, Duan Xiaoming, Zheng Liangliang et al.. Continuous-wave and Q-switched operation of a resonantly

pumped Ho: YAlO₃ laser [J]. Opt. Express, 2008, **16**(9): 14668~14674

- 7 Du Keming, Zhang Hengli, Shi Peng *et al.*. Electro-optically Q-switched Nd: YVO₄ slab laser with a high repetition rate and a short pulse width[J]. *Opt. Lett.*, 2003, **28**(2): 87~89
- 8 Zou Yingyin Kevin, Chen Qiushui, Zhang Run *et al.*. Low voltage, high repetition rate electro-optic Q-switch [C]. Proc. CLEO' 2005, 2005: 1094~1096
- 9 Zhao Jia, Dong Lei, Zhou Zhuang *et al.*. High-repetition-rate RTP electro-optic Q-switched Nd: YAG laser[J]. Infrared and Laser Engineering, 2008, **37**(4): 647~650 赵 佳,董 磊.卓 壮等.高重复率 RTP 电光调 Q Nd: YAG 激 光特性研究[J]. 红外与激光工程, 2008, **37**(4): 647~650
- 10 Yin Xin, Wang Jiyang, Zhang Huaijin *et al.*. Electrooptic properties and electrooptic Q-switch of La₃Ga₅SiO₁₄ single crystal [J]. Jpn. J. Appl. Phys., 2002, 41(12): 7419~7421
- 11 H. Kong, J. Wang, H. Zhang *et al.*. Growth, properties and application as an electrooptic *Q*-switch of langasite crystal[J]. *J. Crystal Growth*, 2003, **254**, 360~367
- 12 Yin Xin, Wang Jiyang, Zhang Shaojun. Study on electro-optic Q-switch of La₃Ga₅SiO₁₄ single crystal [J]. Chinese J. Lasers, 2004, **31**(1): 29~32
 尹 鑫, 王继扬,张少军. La₃Ga₅SiO₁₄ 晶体电光 Q 开关的研究 [J]. 中国激光, 2004, **31**(1): 29~32
- 13 Tian Zhaobing, Zhang Shaojun. Electro-optic Q-switch of an La₃Ga₅SiO₁₄ crystal [J]. Appl. Opt., 2006, 45 (10): 2325~2330
- 14 Wang Chunyu, Zang Huaguo, Li Xiaoli et al.. LD-pumped high repetition rate Q-switched Nd: YVO₄ laser by using La₃Ga₅SiO₁₄ single crystal electro-optic modulator [J]. Chin. Opt. Lett., 2006, 4(6): 329~331
- 15 Li Xiaoli, Shao Jie, Zang Huaguo et al.. High repetition rate short pulse width Nd: YVO4 slab laser[J]. Chinese J. Lasers, 2008, 35(2): 206~210 李小莉,邵 杰,臧华国等. 高重复率窄脉宽 Nd: YVO4板条激光 器[J]. 中国激光, 2008, 35(2): 206~210